【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年3月29日(2012.3.29)

【公表番号】特表2010-521063(P2010-521063A)
【公表日】平成22年6月17日(2010.6.17)
【年通号数】公開・登録公報2010-024
【出願番号】特願2009-552298(P2009-552298)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　27/14　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　31/0232　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　27/14　D
Ｈ０１Ｌ　31/02　D

【手続補正書】
【提出日】平成23年2月28日(2011.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体イメージセンサであって、
基板中のフォトダイオードの光吸収領域と、
前記基板上であって且つ前記光吸収領域に横方向に隣接する誘電体バリアと、
前記誘電体バリア上のコンタクトと、を備え、
前記誘電体バリアが、前記コンタクトを前記基板から絶縁することを特徴とする半導体イメージセンサ。
【請求項２】
前記コンタクトが、前記基板に平行な方向への延長部を備えることを特徴とする請求項１に記載の半導体イメージセンサ。
【請求項３】
前記延長部が、前記基板中の他の一つのフォトダイオードの他の一つの光吸収領域へ光線が通過できるギャップの幅を減少することを特徴とする請求項２に記載の半導体イメージセンサ。